Диэлектрическая нелинейность аморфного материала $Bi_{1.8}Pb_{0.3}Sr_2Ca_2Cu_{3-x}K_xO_z \ (x=0.2-0.3)$

© С.А. Гриднев, Н.И. Репников

Воронежский государственный технический университет, 394026 Воронеж, Россия

E-mail: repnikov@inbox.ru

Исследована зависимость диэлектрической проницаемости от напряженности постоянного электрического поля в аморфном материале $\mathrm{Bi_{1.8}Pb_{0.3}Sr_2Ca_2Cu_{3-x}K_xO_z}$ (x=0.2-0.3). Обнаружено, что с увеличением напряженности постоянного электрического поля величина диэлектрической проницаемости уменьшается по квадратичному закону. Такое поведение диэлектрической проницаемости в постоянном электрическом поле свидетельствует о проявлении нелинейных диэлектрических свойств, которые могут быть описаны в рамках термодинамической теории сегнетоэлектричества.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 04-02-16418).

PACS: 77.22.Ch, 77.84.-s

Недавно появился ряд публикаций, в которых сообщается о возникновении спонтанно поляризованного состояния в полупроводниковых аморфных материалах $Bi_{1.8}Pb_{0.3}Sr_2Ca_2Cu_{3-x}K_xO_z$ (x = 0.1-0.4) [1] и SbSI [2]. Если в [2] результаты объясняются на основе теории Лайнса [3], то в [1] авторы выдвигают иную гипотезу возникновения сегнетоэлектрического состояния в аморфных материалах. Согласно их предположению, сегнетоэлектрическое состояние в изученных аморфных материалах возникает в процессе получения массивных аморфных образцов методом быстрой закалки расплава, в результате чего образуется полярная текстура, связанная с действующими при закалке анизотропными механическими напряжениями. Экспериментальное подтверждение наличия сегнетоэлектрических свойств в аморфных образцах можно получить путем измерения диэлектрической нелинейности (зависимости диэлектрической проницаемости от напряженности электрического поля), характерной для сегнетоэлектриков.

Поэтому целью настоящей работы является изучение низкочастотных диэлектрических свойств аморфного материала $\mathrm{Bi_{1.8}Pb_{0.3}Sr_2Ca_2Cu_{3-x}K_xO_z}$ (x=0.2-0.3) в сильном постоянном электрическом поле.

Образцы аморфного $Bi_{1.8}Pb_{0.3}Sr_2Ca_2Cu_{3-x}K_xO_z$ (x=0.2-0.3) получали сверхбыстрой закалкой расплава методом "молота и наковальни", при этом средний размер выбранных для измерений образцов составлял величину $\sim 0.5 \times 8 \times 8$ mm. Диэлектрические измерения проводились в интервале температур от комнатной до $350^{\circ}C$ на частотах 0.1, 1 и $10\,\mathrm{kHz}$ с использованием измерителя иммитанса E7-14. Для измерения реверсивной нелинейности использовались поля в интервале от 0 до $10\,\mathrm{kV/cm}$.

Методом дифференциального термического анализа (ДТА) была определена температура кристаллизации исследуемого материала $T_{\rm cr} \approx 400^{\circ}{\rm C}$. Кроме экзотермического пика, соответствующего температуре кристаллизации материала $T_{\rm cr}$, на кривой ДТА были обнаружены

еще один экзотермический пик и два эндотермических пика. Два из них наблюдались ниже температуры кристаллизации и находились при $T_c = 250 - 280^{\circ}\mathrm{C}$ и при $T_g = 330 - 350^{\circ}\mathrm{C}$ в зависимости от состава, а третий — выше температуры кристаллизации при $T = 490^{\circ}$ С (рис. 1). Низкотемпературный эндотермический пик, возможно, связан с переходом в аморфном $Bi_{1.8}Pb_{0.3}Sr_2Ca_2Cu_{3-x}K_xO_z$ (x=0.2-0.3), подобным фазовому переходу в кристаллических сегнетоэлектриках, что подтверждают измерения диэлектрической проницаемости на частотах 0.1, 1 и 10 kHz (рис. 2) и рассмотренная далее зависимость диэлектрической проницаемости от напряженности постоянного электрического поля при разных температурах (рис. 3). Эндотермический пик при T_{g} на температурной зависимости сигнала ДТА (рис. 1) характеризует температуру стеклования исследуемого материала, а наличие высокотемпературного пика при

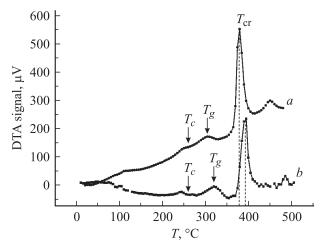


Рис. 1. Температурные зависимости сигнала ДТА для аморфных материалов $Bi_{1.8}Pb_{0.3}Sr_2Ca_2Cu_{2.8}K_{0.2}O_z$ (*a*) и $Bi_{1.8}Pb_{0.3}Sr_2Ca_2Cu_{2.7}K_{0.3}O_z$ (*b*).

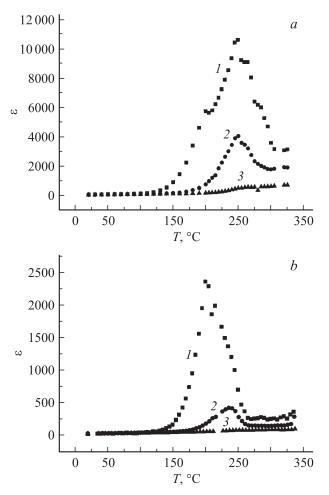


Рис. 2. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости образцов $\mathrm{Bi_{1.8}Pb_{0.3}Sr_2Ca_2Cu_{2.7}K_{0.3}O_z}$ (a) и $\mathrm{Bi_{1.8}Pb_{0.3}Sr_2Ca_2Cu_{2.8}K_{0.2}O_z}$ (b), измеренные на частотах 0.1 (I), 1 (2) и 10 kHz (3).

 $T=490^{\circ}{
m C}$, по-видимому, свидетельствует о том, что процесс кристаллизации является многостадийным.

Для измерений диэлектрической нелинейности были использованы образцы Bi_{1.8}Pb_{0.3}Sr₂Ca₂Cu_{2.7}K_{0.3}O₇ с серебряными электродами. Обнаружено, что с ростом напряженности электрического поля E от 0 до $10\,\mathrm{kV/cm}$ величина диэлектрической проницаемости понижается, так же как и в классических кристаллических сегнетоэлектрических материалах, при температурах ниже T_c (кривые 1 и 2) и не зависит от поля E выше T_c (рис. 3). Однако к нелинейной зависимости диэлектрической проницаемости от напряженности электрического поля может приводить не только нелинейность материала, но и барьер Шоттки, возникающий вблизи поверхности образца, если контакт образец-электрод не является омическим. Для проверки омичности такого контакта были измерены вольт-амперные характеристики (ВАХ) образцов с электродами из разных материалов (рис. 4). Видно, что при значениях напряжения U до 50 V контакт металл (электрод)-полупроводник (исследуемый образец) является нелинейным, но при возрастании величины электрического напряжения на образце барьер Шоттки перестает сказываться и ВАХ становится линейной. Величина электрического напряжения, подаваемого на образец, достигала 400 V; следовательно, зависимость диэлектрической проницаемости

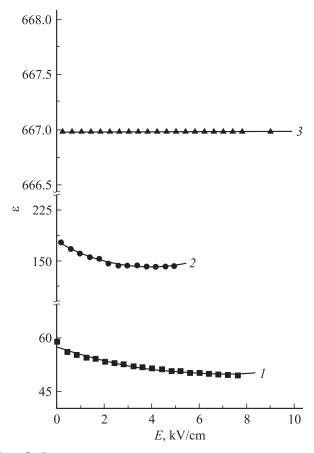


Рис. 3. Зависимости диэлектрической проницаемости от напряженности постоянного электрического поля в аморфном $\mathrm{Bi_{1.8}Pb_{0.3}Sr_2Ca_2Cu_{2.7}K_{0.3}O_z}$ при температурах 17 (*I*), 200 (*2*) и 450°C (*3*), измеренные на частоте 1.5 kHz.

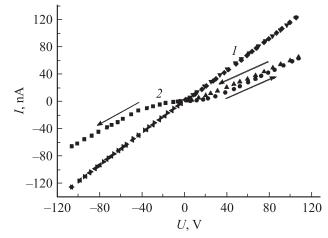


Рис. 4. Вольт-амперные характеристики аморфного $Bi_{1.8}Pb_{0.3}Sr_2Ca_2Cu_{2.8}K_{0.2}O_z$ с электродами In—Ga (I) и серебряными электродами (2) при температуре $20^{\circ}C$.

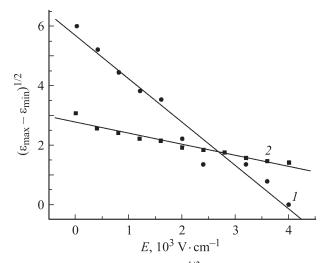


Рис. 5. Зависимости $(\varepsilon_{max} - \varepsilon_{min})^{1/2}$ от E, построенные по данным рис. 3 для температур 200 (I) и 17°C (2).

от напряженности электрического поля является свойством исследуемого образца.

Для объяснения обнаруженной диэлектрической нелинейности можно использовать термодинамический подход [4]. Если рассматривать статический диэлектрический отклик и описывать его, используя разложение в степенной ряд по Ландау

$$E = \alpha P + \beta P^3 + \dots, \tag{1}$$

где P — поляризация, индуцированная электрическим полем E, α и β — термодинамические коэффициенты, то, пренебрегая нелинейными членами более высокого порядка в уравнении (1), можно получить связь между изменением диэлектрической проницаемости $\Delta \varepsilon = \varepsilon_{\max} - \varepsilon_{\min}$ и величиной напряженности электрического поля

$$\varepsilon_{\text{max}} - \varepsilon_{\text{min}} = -3\beta \varepsilon_{\text{min}}^4 \varepsilon_0^3 E^2. \tag{2}$$

В этом выражении ε_{\max} — максимальное значение диэлектрической проницаемости, ε_{\min} — линейная статическая диэлектрическая проницаемость материала.

Для проверки выполнения соотношения (2) зависимость $\Delta \varepsilon$ от поля E была представлена в координатах $(\varepsilon_{\rm max}-\varepsilon_{\rm min})^{1/2}-E$ (рис. 5). Видно, что зависимость изменения диэлектрической проницаемости от квадрата напряженности поля является линейной, что свидетельствует в пользу выполнения зависимости (2), полученной в предположении насыщения индуцированной поляризации в сильных постоянных электрических полях.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что аморфный материал $\mathrm{Bi_{1.8}Pb_{0.3}Sr_2Ca_2Cu_{3-x}}K_xO_z$ (x=0.2-0.3) проявляет в сильном постоянном электрическом поле нелинейные диэлектрические свойства, которые могут быть описаны в рамках термодинамической теории сегнетоэлектричества.

Список литературы

- [1] A.A. Bahgat, T.M. Kamel. Phys. Rev. B 63, 12101 (2001).
- [2] S.N. Kallaev, A.A. Babaev et al. Ferroelectrics 307, 187 (2004).
- [3] M.E. Lines. Phys. Rev. B 15, 1, 388 (1977).
- [4] S. Gridnev, A. Glazunov, A. Tsotsorin. Ferroelectrics 307, 151 (2004).